Домашнее задание 6 (10 баллов)

Измерение концентрации носителей заряда и их подвижности по методу Холла (рис. 1, схема слева).

Для положительного магнитного поля B+ проводят сначала измерения для прямого тока (+I). Например, I_{CA} для получения холловской разности потенциалов U_{BD+} . Не меняя полярности магнита (B+) проводят измерения для противоположного направления тока между теми же контактами - I_{AC} для определения положительного U_{DB+} . То же повторяется для токов I_{DB} (устанавливается U_{AC+}) и - I_{BD} (измеряется U_{CA+}).

Затем меняют полярность магнитного поля (вытаскивают постоянный магнит из установки и вводят его с другой стороны). Аналогично устанавливают значения разностей потенциалов U_{BD-} , U_{DB-} , U_{AC-} и U_{CA-} . На рис. 2 значения напряжений, полученные методом Холла с магнитным полем обведены красным квадратом.

$$U_1 = U_{BD-} - U_{BD+}$$
 $U_2 = U_{DB+} - U_{DB-}$
 $U_3 = U_{AC} + - U_{AC-}$ $U_4 = U_{CA-} - U_{CA+}$

Если сумма ЭДС $U_1 + U_2 + U_3 + U_4$ положительна, то измеряемый образец p-типа, если отрицательна — n-типа. При расчетах не следует забывать производить действие над единицами и помнить, что концентрация носителей заряда выражается в см⁻³:

$$N = \frac{8IB}{ed(U_1 + U_2 + U_3 + U_4)}$$

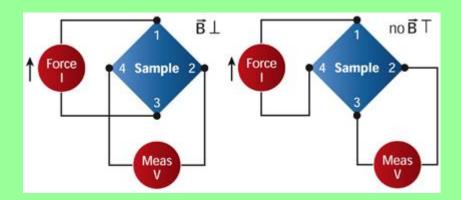


Рисунок 1 – Схемы измерения по Холлу (с магнитным полем, слева) и по Ван дер Пау (без магнитного поля, справа)

При этом напряжение Холла будет:

$$U_H = \frac{U_1 + U_2 + U_3 + U_4}{8}$$

Определение удельного сопротивления по методу Ван дер Пау

выполняют по 8 значениям напряжения на контактах в обход по периметру попарно между двумя контактами пропуская ток, а между двумя другими измеряя напряжение (рис. 1 справа). При этом получают значения напряжений между контактами U_{AB} , U_{-AB} , U_{-BC} , U_{-CD} , U_{-CD} , U_{-DA} . На рис. 2 они обведены синим цветом. Значение удельного сопротивления рассчитывают последовательно применяя формулы:

$$R_{a} = \frac{\pi df (U_{AB} - U_{-AB} + U_{BC} - U_{-BC})}{4I \times ln(2)} \qquad R_{b} = \frac{\pi df (U_{CD} - U_{DC} + U_{DA} - U_{AD})}{4I \times ln(2)}$$

$$\rho = \frac{R_{a} + R_{b}}{2}$$

В этих уравнениях f – это та же поправочная функция, зависящая от соотношения сопротивлений.

Теперь вы можете рассчитать ρ , N и μ заданного образца.

Задание

- 1. Проведите измерения вольт-амперных характеристик контактов к тестируемому образцу. Убедитесь, что все контакты омические (рис. 3).
- 2. По рисунку 2 определите входные параметры холловских измерений своего материала. Возьмите оттуда значения тока I, магнитной индукции B, толщины образца D (в зеленом прямоугольнике) и главное! правильно подставьте значения напряжений в соответствующих окнах программы в формулы теоретической части описания к этой работе.

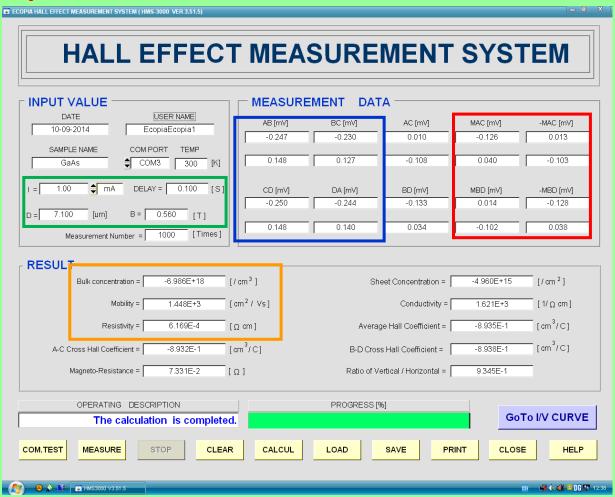


Рисунок 2 – Окно программы для расчетов задачи

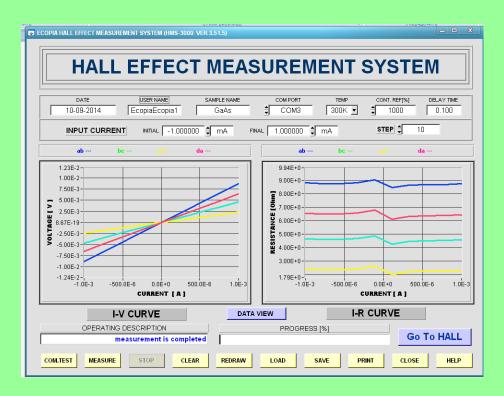
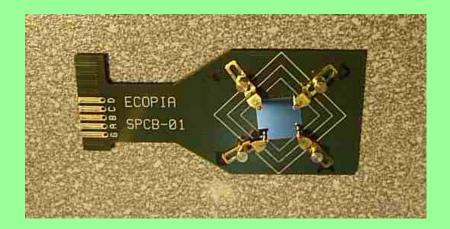


Рисунок 3 – BAX контактов к пленке GaAs

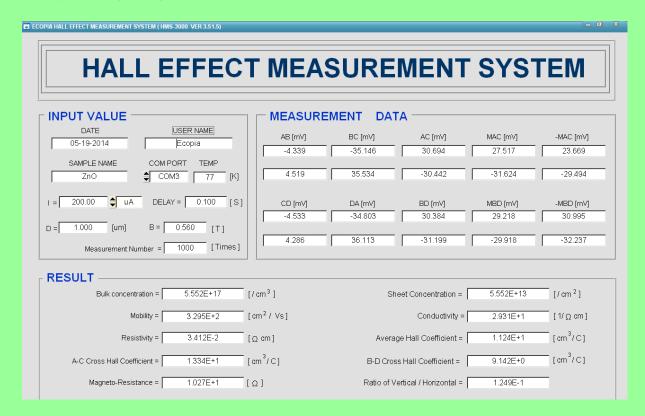


Для каждого студента предлагается провести собственный расчет его индивидуального задания. Рис. 2 делает Жанель.

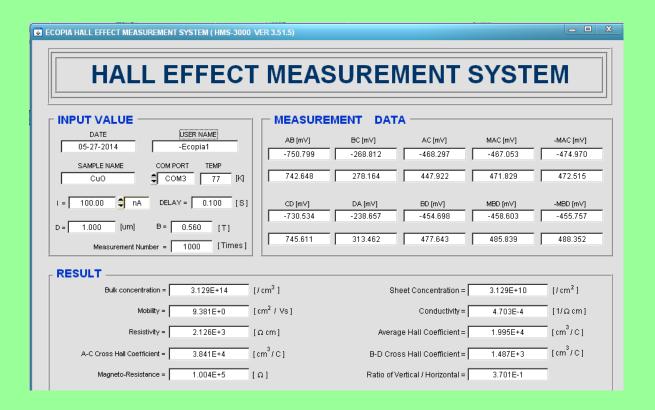
В результате расчетов вы должны получить значения концентрации носителей (bulk concentration), их подвижности (mobility) и удельного сопротивления образца (resistivity) как в окне вашей программы (эти параметры на рис. 2 обведены оранжевым прямоугольником). Точность совпадения – до третьего знака после запятой. Правильно также должен быть определен тип проводимости образца.

Внимание! Если у вас не получаются такие значения, как в окне вашей программы, не присылайте мне решение на проверку! Можно прислать с вопросом – вот ход моего решения, что я делаю не так?

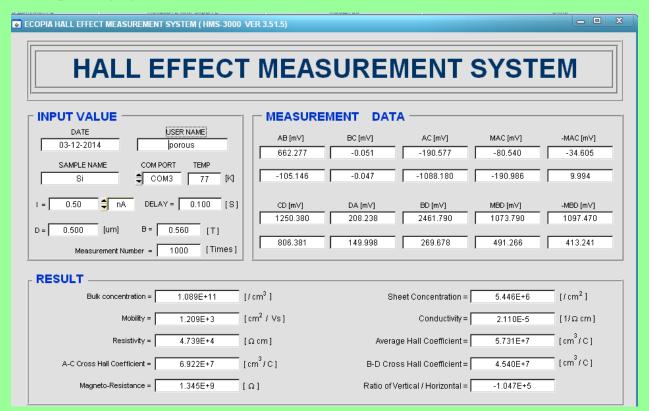
Руслан (ZnO)



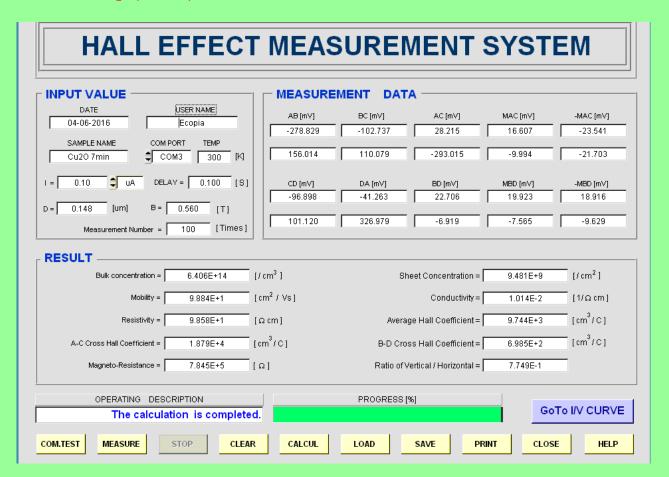
Жан (СиО)



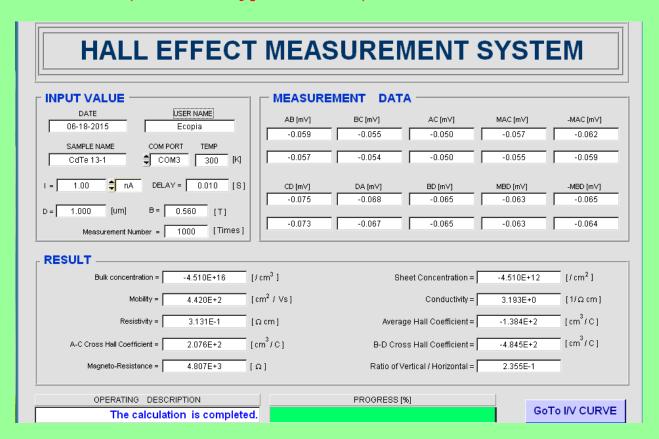
Ердос (Si)



Алишер (Си₂О)



Шолпан (CdTe - теллурид кадмия)



Азамат (GaAs:Sn,Te)

